

СОДЕРЖАНИЕ

Том 53, номер 3, 2024

ДИАГНОСТИКА

- Комплексное исследование неравномерности свойств тонкопленочного катода LiCoO_2 , изготовленного методом ВЧ-магнетронного распыления
С. В. Курбатов, А. С. Рудый, В. В. Наумов, А. А. Мироненко, О. В. Савенко, М. А. Смирнова, Л. А. Мазалецкий, Д. Э. Пухов 189
- Влияние добавки водорода на электрофизические параметры и спектры излучения плазмы тетрафторметана
Д. Б. Мурун, А. Ю. Граждан, И. А. Чесноков, И. А. Гоголев 206
-

МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Тепловое моделирование и оптимизация топологии GaN интегральной схемы полумоста с драйвером управления и силовыми транзисторами
В. А. Кагадей, И. Ю. Кодорова, Е. С. Полинцев 212
- Моделирование кремниевых полевых конических GAA-нанотранзисторов со стековым $\text{SiO}_2/\text{HfO}_2$ подзатворным диэлектриком
Н. В. Масальский 222
- Кинетика электромиграционного массопереноса в интерфейсных элементах микро- и наноэлектроники в зависимости от прочности тонкопленочных соединений
Т. М. Махвиладзе, М. Е. Сарычев 232
-

ПАМЯТЬ

- Структура и формирование энергонезависимых ячеек памяти SuperFlash
Д. А. Абдуллаев, Е. В. Боброва, Р. А. Милованов 243
-

ПРИБОРЫ

- Разработка приборной структуры Ge-МДПТ с индуцированным каналом p -типа
Н. А. Алябина, Е. А. Архипова, Ю. Н. Бузынин, С. А. Денисов, А. В. Здоровейшев, А. М. Титова, В. Ю. Чалков, В. Г. Шенгуров 259
- Анализ механизмов рассеяния носителей в AlN/GaN НЕМТ-гетероструктурах с ультратонким AlN барьером
А. С. Гусев, А. О. Султанов, А. В. Катков, С. М. Рындя, Н. В. Сигловая, А. Н. Клочков, Р. В. Рыжук, Н. И. Каргин, Д. П. Борисенко 265
- Влияние лазерного излучения на функциональные свойства приборных МОП-структур
С. Ш. Рехвиашвили, Д. С. Гаев 274